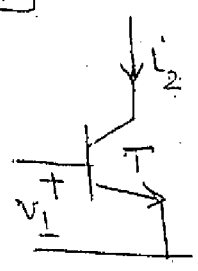


موضوع: تحلیل مدارهای غیر خطی ترانزیستور BJT

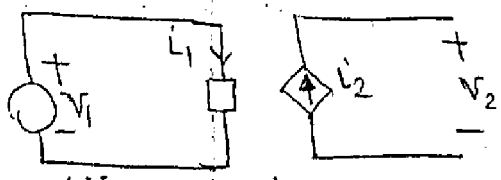
$$\frac{10}{ccir}$$

۹۱۲۴۵۵۲۰۲۶

مدل غیر خطی ترانزیستور



یک ترانزیستور BJT منبع جریان وابسته غیر خطی از نوع منافی است



$$I_2 = I_s \exp\left(\frac{V_1}{V_T}\right)$$

داده آن:  $V_T = \frac{kT}{q}$   $V_T \approx 26$  mV  $T = 300^{\circ}K$

فرض می‌کنیم  $V_1$  شامل یک مؤلفه dc و یک مؤلفه ac باشد:  
 الزاماً  $V_1$  خلی کوچک است

$$V_1(t) = V_{DC} + V_1 \cos(\omega t)$$

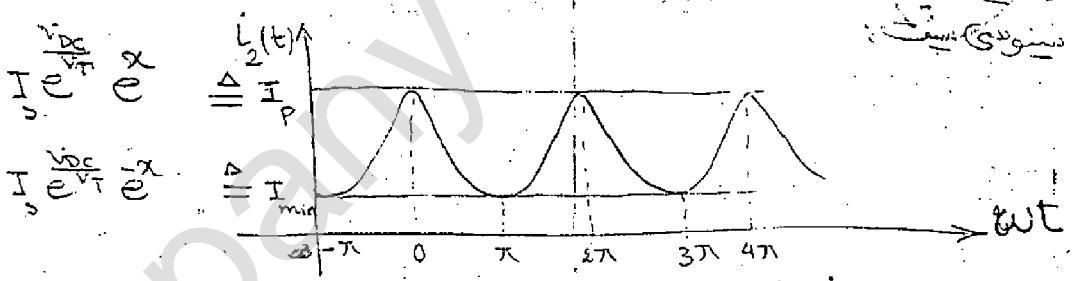
$$\Rightarrow I_2(t) = I_s e^{\frac{V_{DC}}{V_T}} e^{\frac{V_1}{V_T} \cos(\omega t)}$$

دامنه آن تا این سده مؤلفه ac ورودی

$$\alpha = \frac{V_1}{V_T}$$

$$\Rightarrow I_2(t) = I_s e^{\frac{V_{DC}}{V_T}} e^{\alpha \cos(\omega t)}$$

این حالت  $I_2(t)$  را مساوی بودولی



جریان  $I_2(t)$  را چس می‌نویسیم:  $I_2(t) = \frac{I_P}{e^x}$

جریان  $I_2(t)$  را آن یک سینکال زوجی است به سری فوریه بسط می‌دهیم

$$\Rightarrow I_2(t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega t) + \frac{1}{2} a_0$$

داده آن:  $a_n = \frac{2}{T} \int_0^T I_2(t) \cos(n\omega t) dt = \frac{2}{T} \int_0^T \frac{I_P}{e^x} e^{\alpha \cos(\omega t)} \cos(n\omega t) dt$

تجربیم:  $\theta = \omega t \Rightarrow dt = \frac{d\theta}{\omega} \Rightarrow a_n = \frac{2I_P}{\omega} \int_0^{2\pi} \frac{e^{\alpha \cos \theta}}{e^x} \cos(n\theta) d\theta$

موسسه تخصصی زبان دانشگاه تهران

$$\bar{I}_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{j n \theta} G_n(\theta) d\theta \quad n=0, 1, 2, \dots$$

لازم است که در صورت تحلیلی برای توابع بسط به وجود یافته امکان پذیر نبوده بلکه آنجا به صورت جدول و یا منحنی ارائه می شود (برای اطلاعات بیشتر به ضمیمه ۳ در کتاب رجوع شود) پس داریم:

$$a_n = \frac{2 I_p}{e^x} \bar{I}_n(x)$$

$$i_2(t) = \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 I_p}{e^x} \bar{I}_n(x) G_n(n\omega t) \right\} + \frac{I_p I_0(x)}{e^x}$$

$$\Rightarrow i_2(t) = \frac{I_p}{e^x} I_0(x) + \frac{2 I_p}{e^x} \bar{I}_1(x) G_1(\omega t) + \dots$$

(مؤلفه DC جریان  $i_2(t)$ )  $I_{dc}$

$$\frac{I_{dc}}{e^x} = \frac{I_p}{I_0(x)} \Rightarrow \frac{I_p}{e^x} = \frac{I_{dc}}{I_0(x)}$$

پس  $i_2(t)$  را چنین می توان نوشت:

$$i_2(t) = I_{dc} \left\{ 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \bar{I}_n(x)}{I_0(x)} G_n(n\omega t) \right\}$$

توان خروجی در ...  
تلفات

توابع  $\frac{2 \bar{I}_n(x)}{I_0(x)}$  در جدول 5-1 از فصل چهارم کتاب به صورت عددی و در شکل 5-5 از همین فصل به صورت نمودار داده شده اند.

$$\lim_{x \rightarrow 0} I_0(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \bar{I}_n(x) = \frac{(x/2)^n}{n!}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \bar{I}_1(x) = \frac{x}{2}$$

پس برای  $x$  ها کوچک داریم:

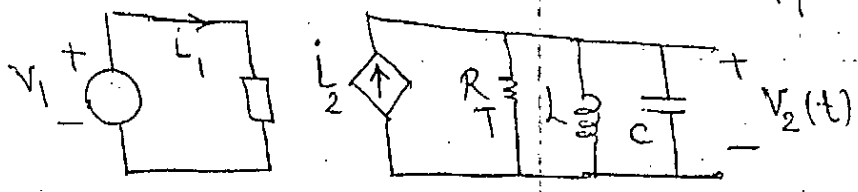
$$i_2(t) \approx I_{dc} (1 + x G_1(\omega t)) = I_{dc} + I_{dc} x G_1(\omega t)$$

$$\frac{I_{dc}}{e^x} = \left( \frac{I_{dc}}{V_T} \right) V_1$$

$$\frac{g_m}{m} \triangleq \frac{I_{dc}}{V_T} \Rightarrow i_2(t) = I_{dc} + \frac{g_m}{m} V_1 G_1(\omega t)$$

با سطح سیگنال کوچک

11  
 11/11  
 الفون اجازه دهنده -> جنبه خروجی بزرگ میانه میان گذر (مستدا)  
 RLC موازی با  $\Phi_T$  بالا و بزرگ شدن مرکزی  $\omega$  قرار دهم:



-> این حالت خواهیم داشت:  
 $V_2(t) = R \times I_2(t)$  ها - مونتک اصلی

$$\Rightarrow V_2(t) = R \times \left( \frac{2I_1(\omega)}{I_0(\omega)_{dc}} I_{Co} \cos(\omega t) \right)$$

اجازه دهنده ترانس کنده ولتاژش (Trans-Conductance) مولفه اصلی  $V_2(t)$  را چینی تعریف کنیم:

$$G_m(\omega) \triangleq \frac{\text{دامنه ها مونتک اصلی } V_2(t)}{\text{دامنه مولفه ac ولتاژ } V_1(t)} = \frac{2I_1(\omega) I_{Co}}{I_0(\omega)_{dc} V_1}$$

$$\Rightarrow \frac{2I_1(\omega)}{I_0(\omega)_{dc}} I_{Co} = G_m(\omega) V_1$$

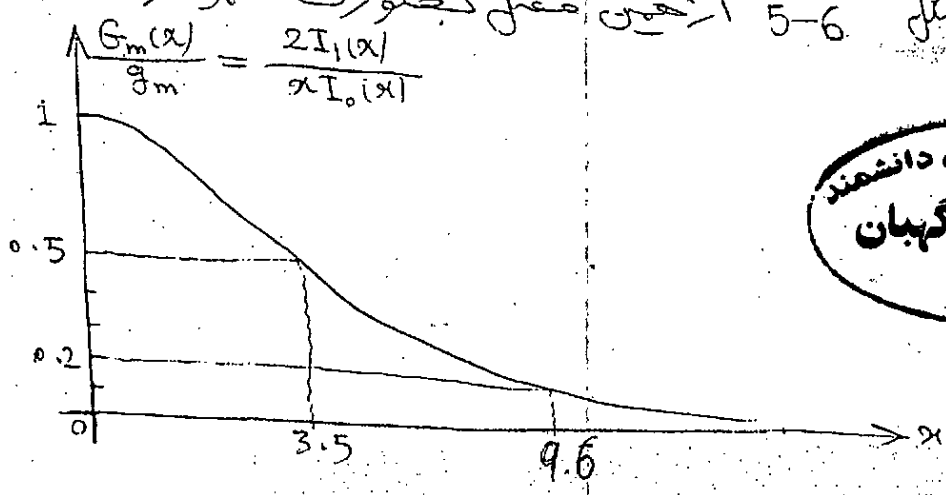
$$\Rightarrow V_2(t) = G_m(\omega) V_1 R \cos(\omega t)$$

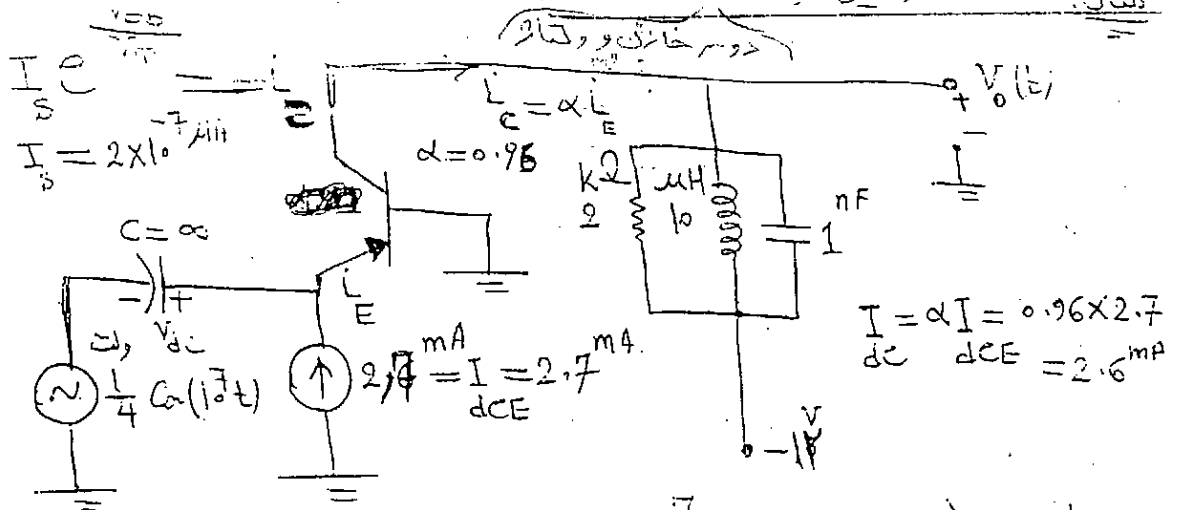
$$G_m(\omega) = \frac{2I_1(\omega)}{I_0(\omega)} \frac{\frac{I_{dc}}{V_T}}{\frac{V_1}{V_T}} \Rightarrow G_m(\omega) = \frac{2I_1(\omega) g_m}{\omega I_0(\omega)}$$

دقیق کنیم که:

$$\Rightarrow \frac{G_m(\omega)}{g_m} = \frac{2I_1(\omega)}{\omega I_0(\omega)}$$

جدول 5-2 از شکل 5-6 در صورت عددی  
 شکل 5-6 از همین شکل در صورت نمودار داده شده  
 است:





حل: داریم

$$V_{EB} = V_{dc} + \frac{1}{4} G_m (10^7 t)$$

محوولات اما  $I_{dc}$  معلوم  $V_{dc}$

$$\alpha I_{dc} = I_{dc} = 2.6 \text{ mA}$$

$$\alpha = \frac{V_1}{V_T} = \frac{250 \text{ mV}}{26 \text{ mV}} \approx 9.6 \Rightarrow I_P = \frac{2.6 \text{ mA} \times 9.6}{I_0 (9.6)}$$

$$I_{dc} = \frac{I_P}{e^{\alpha}} I_0 (\alpha) \Rightarrow I_P = 21.3 \text{ mA}$$

$$I_P = I_s \alpha e^{\frac{V_{dc}}{V_T}} \Rightarrow e = \frac{I_P}{I_s \alpha}$$

$$\Rightarrow V_{dc} = V_T \ln\left(\frac{I_P}{I_s \alpha}\right) = 26 \text{ mV} \ln\left(\frac{21300 \mu\text{A}}{e^{9.6} \times 2 \times 10^{-7} \text{ A}}\right) = 410 \text{ mV}$$

$$g_m = \frac{I_{dc}}{V_T} = \frac{2.6 \text{ mA}}{26 \text{ mV}} = 0.1 \text{ S}$$

$$\alpha = 9.6 \Rightarrow \frac{G_m(\alpha)}{g_m} \approx 0.2 \Rightarrow G_m(\alpha) = 0.2 \times 0.1 = 2 \times 10^{-2} \text{ S}$$

فرکانس مرکزی

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L C}} = 10^7 \text{ rad/s}$$

ها چونند  $Q_T = R_T \omega_0 = 20 \Rightarrow V_o(t) = V_{cc} + R_T \times \dots$

$$= G_m(\alpha) V_1$$

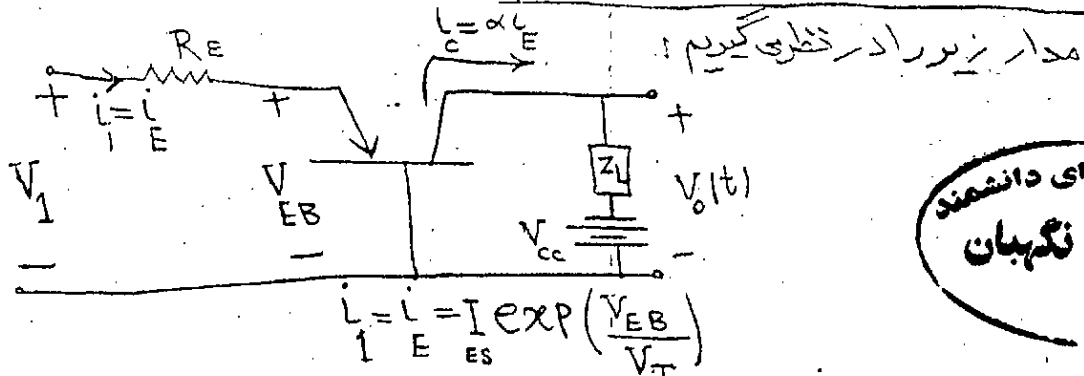
$$\Rightarrow V_o(t) = -14 + 20 \times 2 \times 10^{-2} \times \frac{1}{4} G_m (10^7 t)$$

$$\Rightarrow V_o(t) = -14 + 10 G_m (10^7 t) = -12 + 10 G_m (10^7 t)$$

$V_{EB \text{ bias}} = 0.605$

برای این فرکانس

همچنین



خدمات رایانه ای دانشمند  
برادران نگهبان  
کلمه:

رابطه  $V_1$  و  $V_0$  را در حالت 1 سیگنال کوچک

$$V_1 = R_E I_E + V_T \ln\left(\frac{I_E}{I_{ES}}\right) \quad (1)$$

در حالت سیگنال کوچک مقاومت دینامیکی در ورودی مدار چیست:

$$r'_{in} = \left. \frac{\partial V_1}{\partial I_E} \right|_{V_{EB} = I_{ES} V_T} = R_E + r_{in} \quad \text{و} \quad r_{in} = \frac{V_T}{I_{E_{dc}}} \quad (2)$$

از طرفی گذر ولتاژش  $g_{in}$  چیست تعریف می شود.

$$g_{in} = \frac{1}{r_{in}} = \frac{I_{E_{dc}}}{V_T} \quad (3)$$

در این حالت سیگنال کوچک ترانس اندوکتانس  $g'_m$  چیست تعریف می شود:

$$g'_m = \left. \frac{\partial I_C}{\partial V_1} \right|_{V_{EB} = I_{ES} V_T}$$

با توجه به تعریف  $r'_{in}$  مقدار  $g'_m$  چیست بدست می آید:

$$g'_m = \frac{\alpha}{r'_{in}} = \frac{\alpha}{R_E + \frac{1}{g_{in}}}$$

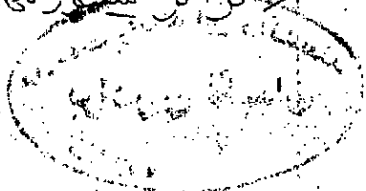
$$\Rightarrow g'_m = \frac{\alpha g_{in}}{1 + g_{in} R_E} \quad (4)$$

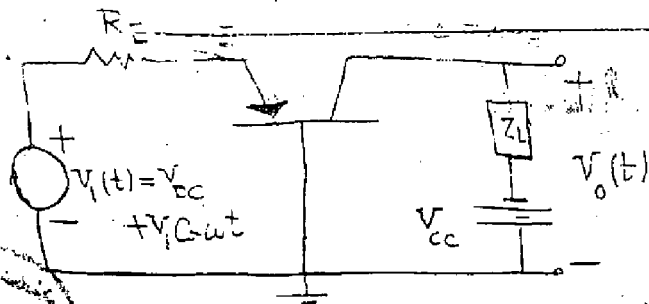
مشاهده می شود وجود مقاومت  $R_E$  باعث کاهش ترانس اندوکتانس  $g'_m$  می شود است.

$$(g'_m = g'_m |_{R=0} = \alpha g_{in})$$

هرگاه  $1 \ll g_{in} R_E$  آنگاه:  $g'_m \approx \frac{\alpha}{R_E}$  یعنی  $g'_m$

مستقل از نقطه کار ترانس اندوکتانس می شود.





و توی  $V_1$  بزرگ  
 باسد  $E$  و  $V_{cc}$  مقادیر

ولی غیر سینوسی خواهند بود  
 در این حالت نیز

تعریف می کنیم:

$$G_m = \frac{\text{دامنه خروجی مولفه ac ولتاژ اصل}}{\text{دامنه مولفه ac ولتاژ ورودی}}$$

حجین ولتاژ  $V_{cc}$  را حین تعریف می کنیم

$$V_{Co} = V_T (1 + g_{in} R_E)$$

براحتی می توان ثابت کرد که

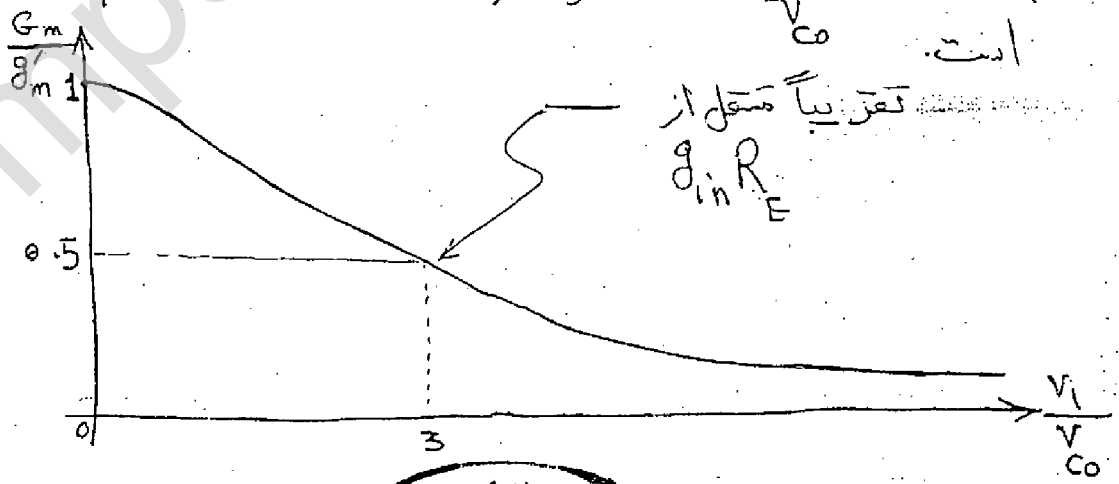
در مدار فوق  $\frac{G_m}{g_m}$  تابعی از  $\frac{V_1}{V_{Co}}$  و  $g_{in} R_E$

است (  $V_1$  دامنه مولفه ac سینال  $V_1(t)$  است )  
 ( برای دیدن اثبات به قسمت 8 از فصل 4 کتاب مراجعه کنید )

البته وابستگی  $\frac{G_m}{g_m}$  به پارامتر  $g_{in} R_E$  بسیار ناچین

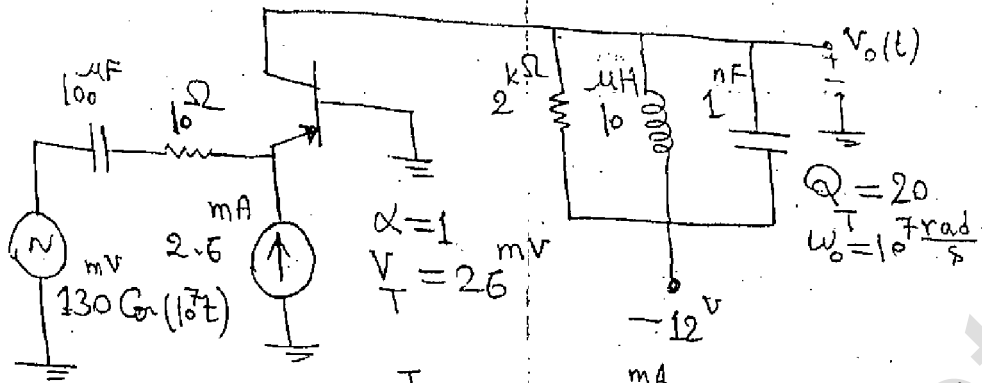
است. نمودار تابع  $\frac{G_m}{g_m}$  ( به ازای مقادیر مختلف  $g_{in} R_E$  )

بر حسب  $\frac{V_1}{V_{Co}}$  - نمودار 8.6 از فصل 4 رسم شده  
 است.



خدمات رایانه ای دانشمند  
 برادران نگهبان  
 تلفن ۱

مثال - مدار زیر را با مقادیر داده شده تحلیل کنید.



$$g_{in} = \frac{I_{DQ}}{V_T} = \frac{2.6 \text{ mA}}{26 \text{ mV}} = 0.1 \text{ S}$$

$$\Rightarrow V_{co} = 26 \text{ mV} (1 + 0.1 \times 10) = 52 \text{ mV}$$

$$\Rightarrow \frac{V_i}{V_{co}} = \frac{130}{52} = 2.5 \Rightarrow \frac{G_m}{g'_m} = 0.6$$

$$g'_m = \frac{\alpha g_{in}}{1 + g_{in} R_E} = \frac{1 \times 0.1}{2} = \frac{1}{20} \text{ S}$$

$$\Rightarrow G_m = \frac{6}{10} \times \frac{1}{20} = 0.03 \text{ S} \Rightarrow I_{DQ} = G_m V_i = \frac{3}{100} \times 130 \text{ mA} = 3.9 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow V_0(t) = -12 \text{ V} + 2 \text{ k}\Omega \times 3.9 \text{ mA} \cos(10^7 t) = -12 + 7.8 \cos(10^7 t) \text{ V}$$

خدمات رایانه ای دانشمند  
برادران نگهبان  
تلفن:

مدل حین حلقی ترانزیستور FET

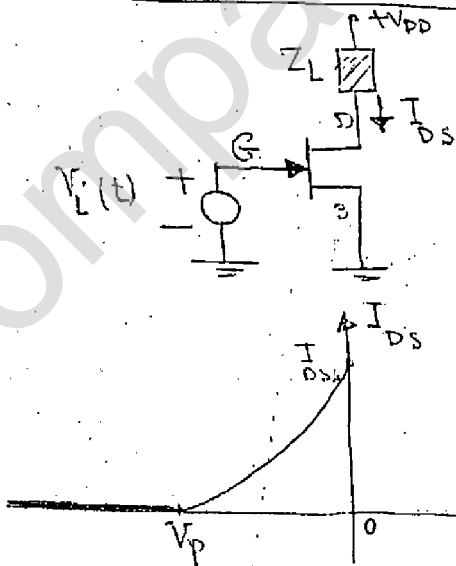
ترانزیستور FET با تقریب بسیار خوبی داریم:

$$I_{DS} = \begin{cases} I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 & V_P < V_{GS} < 0 \\ 0 & V_{GS} \leq V_P < 0 \end{cases}$$

هرگز نباید  $V_{GS} < 0$  شود زیرا

جریان  $I_{DS}$  به شدت

افزایش یافته و ترانزیستور میسوزد.



$$V_i(t) = V_{DC} + V_1 \cos(\omega t), \quad V_p \leq V_i(t) \leq 0$$

$$I_{DS} = \frac{I_{DSS}}{V_p^2} (V_p - V_{GS})^2 = \frac{I_{DSS}}{V_p^2} \left( V_p^2 + V_{GS}^2 - 2V_p V_{GS} \right)$$

$$\Rightarrow I_{DS} = \frac{I_{DSS}}{V_p^2} \left( V_p^2 + V_{DC}^2 + 2V_p V_{DC} \cos(\omega t) + V_1^2 \cos^2(\omega t) - 2V_p V_{DC} - 2V_p V_1 \cos(\omega t) \right)$$

→ این حالت به  $I_{DS}$  به سری خوردن فقط دارای سه جمله است:

$$I_{DS}(t) = I_0 + I_1 \cos \omega t + I_2 \cos 2\omega t$$

$$I_0 = \frac{I_{DSS}}{V_p^2} \left( V_p^2 + \frac{V_1^2}{2} \right)$$

$$V_x = V_p - V_{DC}$$

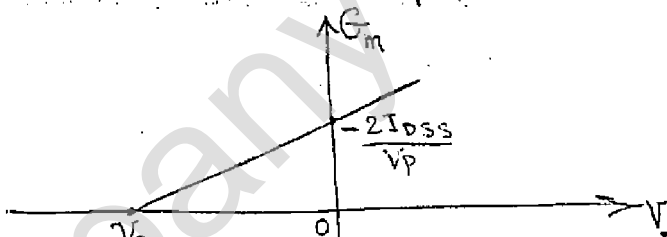
$$I_1 = -2 \frac{I_{DSS}}{V_p^2} V_p V_1$$

$$I_2 = \frac{I_{DSS}}{V_p^2} \frac{V_1^2}{2}$$

برای این مدار ترانس کذورتانس  $G_m$  چنین تعریف می شود:

$$G_m = \frac{I_1}{V_1} \Rightarrow G_m = -2 \frac{I_{DSS}}{V_p^2} V_p = \frac{2I_{DSS}}{V_p} (V_{DC} - V_p)$$

چقدر حالب! چونکه  $G_m$  مستقلاً  $V_1$  است.



خاصیت حالب دیگر آنند  $G_m$  با ترانس کذورتانس یکسان است (که  $G_m$ )

در نقطه  $V_{GS} = V_{DC}$  برابر است، چونکه:

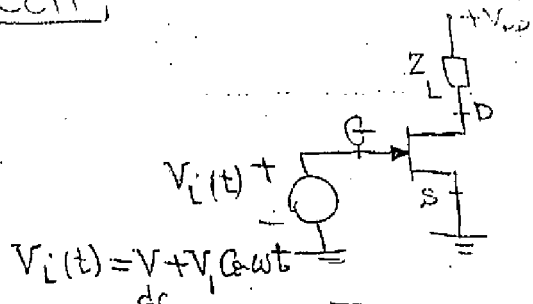
$$g_m = \left. \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{GS}} \right|_{V_{GS} = V_{DC}} = -2 \frac{I_{DSS}}{V_p} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right) \Big|_{V_{GS} = V_{DC}}$$

$$\Rightarrow g_m = -\frac{2I_{DSS}}{V_p^2} V_x \Rightarrow g_m = G_m$$

التهون فرض می کنیم  $V_1$  آنقدر زیاد باشد که ترانس استور به ناحیه قطع نرسد.

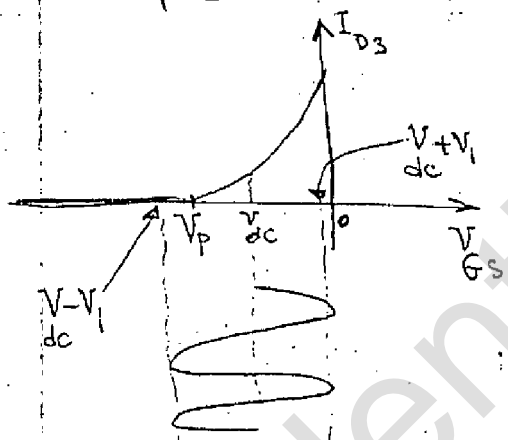


این ترانزیستور در حالت سیتور با ولتاژ ورودی  $V_i(t)$  و ولتاژ خروجی  $V_o(t)$  و جریان  $I_{D_S}$  در خروجی و ولتاژ  $V_{GS}$  در ورودی ترانزیستور FET به ناحیه قطع هم برود.

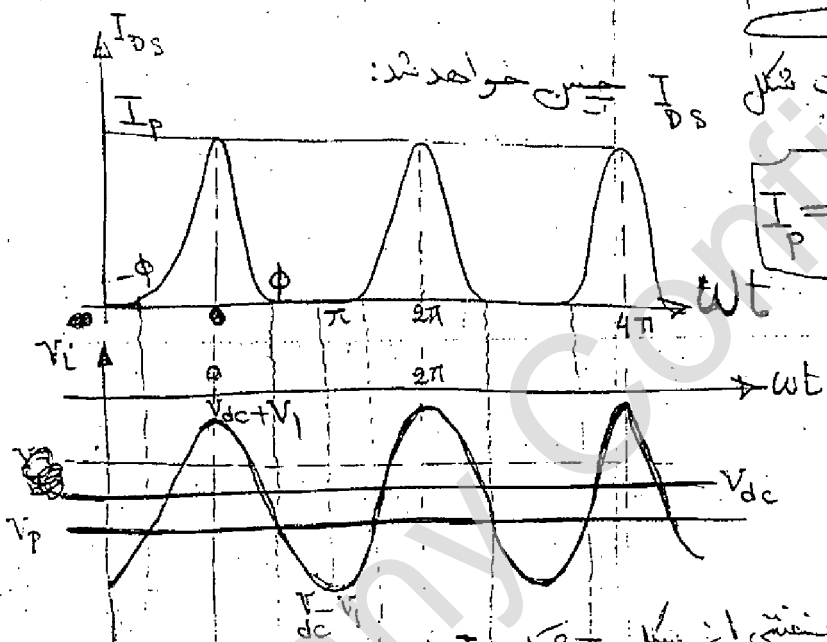


$$V_i(t) = V_{dc} + V_1 \cos \omega t$$

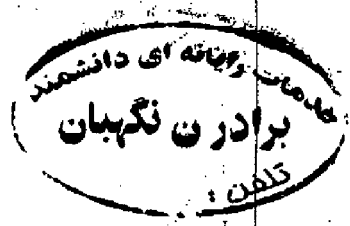
$$V_{dc} - V_1 < V_p \quad \text{و} \quad V_{dc} + V_1 < 0$$



چنین خواهد شد:



$$I_p = \frac{I_{DSS}}{V_p^2} (V_{dc} - V_1)^2$$



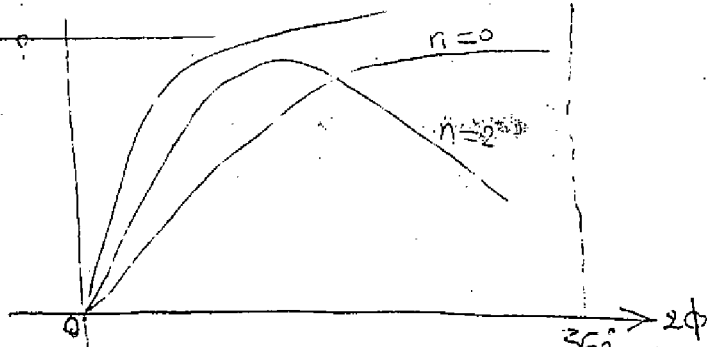
زاویه هدایت (نسبتی از  $2\pi$  در  $I_{D_S}$  غیر صفر است) چنین محاسبه می شود:

$$V_i = V_p \Rightarrow V_{dc} + V_1 \cos(\phi) = V_p \Rightarrow \phi = \arccos\left(\frac{V_p - V_{dc}}{V_1}\right)$$

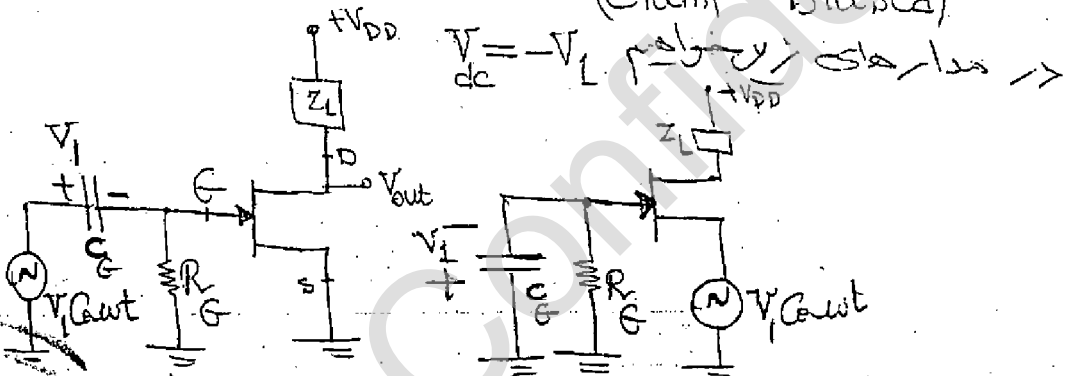
$$\Rightarrow 2\phi = 2 \arccos\left(\frac{V_p - V_{dc}}{V_1}\right) \quad \left[ V_p = V_{dc} - V_{gs} \right]$$

در این حالت سیتور  $I_{D_S}$  به سری خوردن مشابه بی شما جدا خواهد بود. ضرایب سری خوردن تابعی از  $I_p$  و  $2\phi$  خواهد بود. در شکل 4-4 از فصل چهارم کتاب نمودارهای  $\frac{I_0}{I_p}$ ،  $\frac{I_1}{I_p}$  و  $\frac{I_2}{I_p}$  بر حسب  $2\phi$  (زاویه هدایت) رسم شده است.

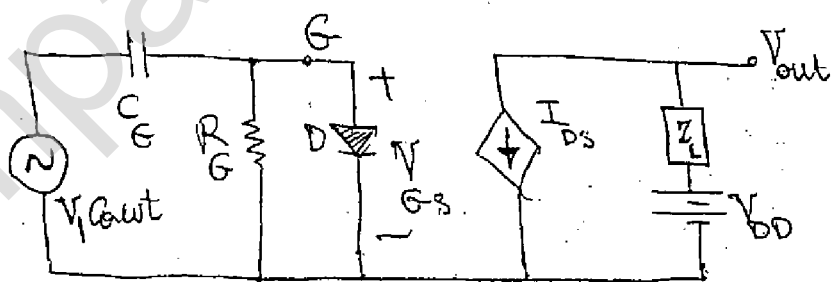
$$\left( I_{D_S} = I_0 + I_1 \cos \omega t + I_2 \cos 2\omega t + \dots \right)$$



شکل 4-5 از جدول چهارم کتاب خردارهای  $\frac{I_n}{I_p}$  ( $n=0$  تا  $2$ )  
 را بر حسب  $\phi = \alpha$  نشان می دهد  
 یک حالت خاص مهم: ( $V_{dc} = -V_1$ )  
 (Clamp Biased)

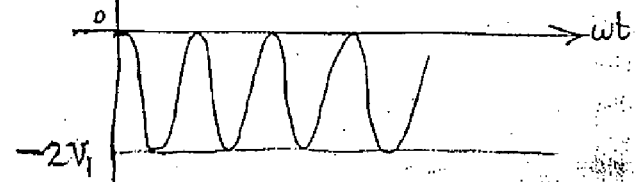


ثابت زمانی  $R_G C_G$  خیلی بزرگتر از  $T = \frac{2\pi}{\omega}$  می باشد (فرض می شود) بنابراین ولتاژ خازن  $C_G$  از طریق دیود  $D$  تا قبل از اینکه  $V_{GS}(t) = V_1 \cos(\omega t)$  شارژ شده و در همان مقدار ثابت می ماند چون مدار معادل FET (مدارهای فوق) چنین است:



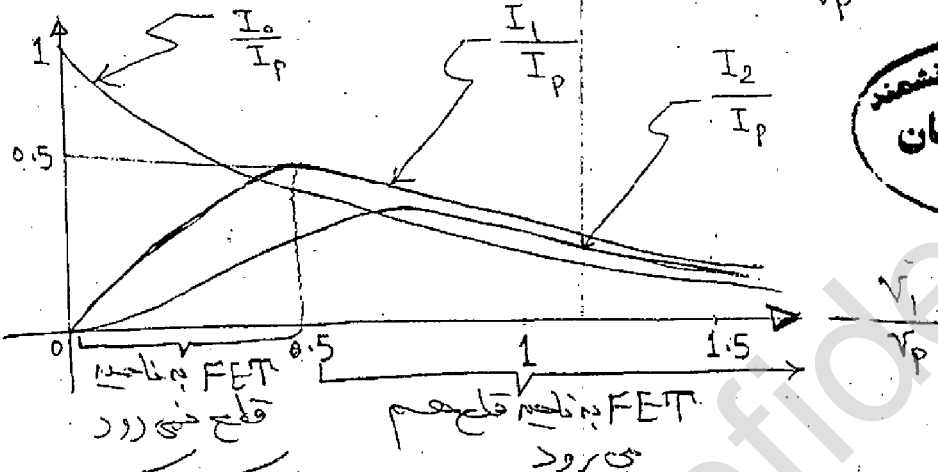
پس داریم:  $V_{GS} = V_1 (\cos(\omega t) - 1)$

اگر  $V_p < -2V_1$  باشد آنگاه ترانزیستور FET به ناحیه قطع می خواهد رفت.



در وقت ایتم که در این حالت خاص داریم:  $I_p = I_{DSS}$  و  $V_x = V_p + V_1$

شکل 3-9 از فصل چهارم کتاب مکتوب منحنی های  $\frac{I_0}{I_p}$ ،  $\frac{I_1}{I_p}$  و  $\frac{I_2}{I_p}$  را بر حسب  $\frac{V_1}{V_p}$  رسم کرده است. این منحنی ها چنین هستند:



خدمات رایانه ای دانشمند  
برادران نگهبان  
گلفن

در این حالت خاص (Clamp-Biased) ترانس کنده و گتاس مؤلفه اصلی سیگنال بزرگ را چنین تعریف می کنیم:

$$G_m = \frac{I_1}{V_1}$$

$I_1$ : دامنه خروجی موئید اصلی  $I_{DSS}$   
 $V_1$ : دامنه ورودی

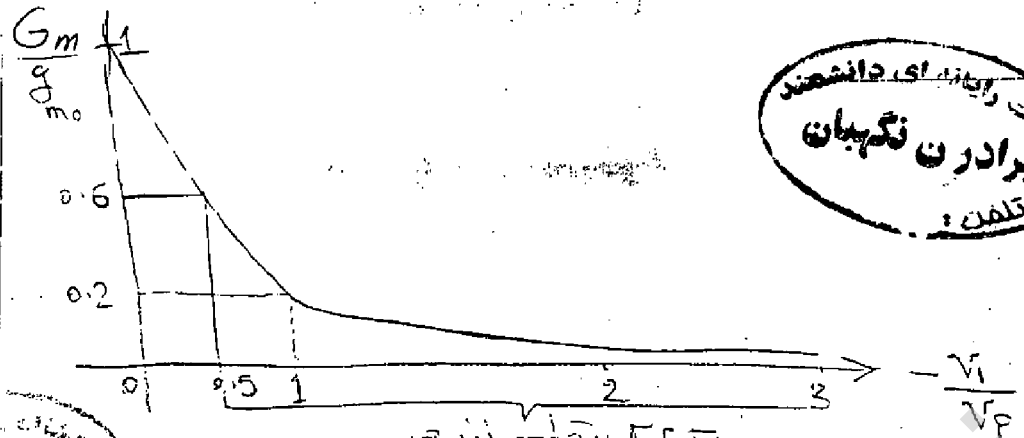
$$G_m = \frac{I_1}{V_1} = \frac{2 I_{DSS} I_1}{-2 V_p \left( \frac{-V_1}{V_p} \right)} = g_{m0} \frac{I_1/I_p}{2 \left( -V_1/V_p \right)}$$

ترانس کنده و گتاس سیگنال کوچک  $g_{m0} = \frac{2 I_{DSS}}{-V_p}$  که در آن:

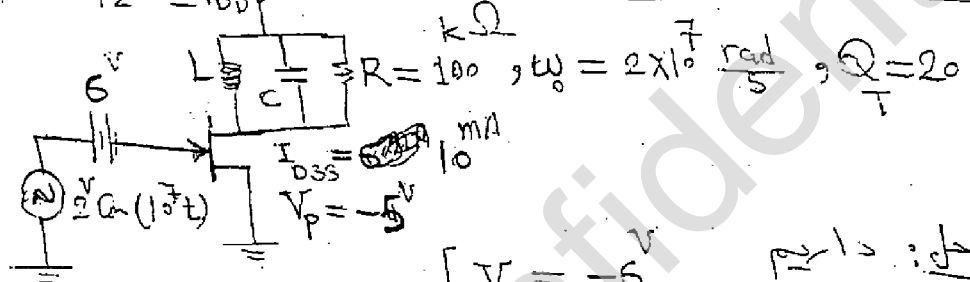
$$G_m = \frac{I_1/I_p}{2 \left( -V_1/V_p \right)}$$

چون  $\frac{I_1}{I_p}$  تابعی از  $\frac{-V_1}{V_p}$  است پس  $\frac{G_m}{g_{m0}}$  نیز تابعی از

$\frac{-V_1}{V_p}$  خواهد بود. شکل این تابع در شکل 3-4 از فصل چهارم کتاب به صورت زیر رسم شده است:



FET به قطع نینس ورود  
مثال (برای حالت کلی): مدار زیر (تا  $V_0$ ) را بدست آورید.  
 $12V = V_{DD}$



حل: داریم

$$\begin{cases} V_{dc} = -6 \\ V_1 = 2 \end{cases}$$

$\Rightarrow V_{dc} + V_1 = -4 < 0 \Rightarrow$  FET نمی بسوزد  
 $V_{dc} - V_1 = -8 < V_p \Rightarrow$  FET به ناحیه قطع هم می رود

$\Rightarrow 2\phi = 2 \arccos\left(\frac{V_x}{V_1}\right)$       $V_x = V_p - V_{dc} = -5 + 6 = 1$

$\Rightarrow 2\phi = 2 \arccos\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \times 6^\circ \Rightarrow \boxed{2\phi = 12^\circ}$

$I_p = \frac{I_{DSS}}{V_p^2} (V_x - V_1)^2 = \frac{10 \text{ mA}}{25} \times (1 - 2)^2 = \frac{2}{5} = 0.4 \text{ mA}$

بفا طرح وجود نینس میان گذر با  $Q_T$  بالا داریم؟

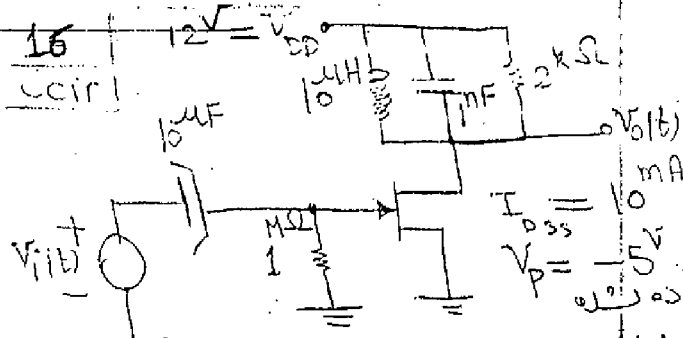
ها - مونتک دوم  $V_0(t) = V_{DD} - R \times I_{DSS}$

از شکل 4-4 داریم؟  $2\phi = 12^\circ \Rightarrow \frac{I_2}{I_p} = 0.23$

$\Rightarrow I_2 = 0.23 \times 0.4 \text{ mA} = 9.2 \times 10^{-3} \text{ mA}$

$\Rightarrow \boxed{V_0(t) = 12 - 9.2 \cos(2 \times 10^7 t)}$

پس مدار خروجی فرکانس ورودی را دو برابر کرده است.



مدار (برای حالت پایدار):  
 مدار ریس  $V_o(t)$  را  
 بیابید.

$V_i(t) = 5 \cos(10^7 t)$

حل: برای مدار RLC داده شده داریم:  
 $\omega_0 = 10^7 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$   
 $Q = RC\omega_0 = 20$

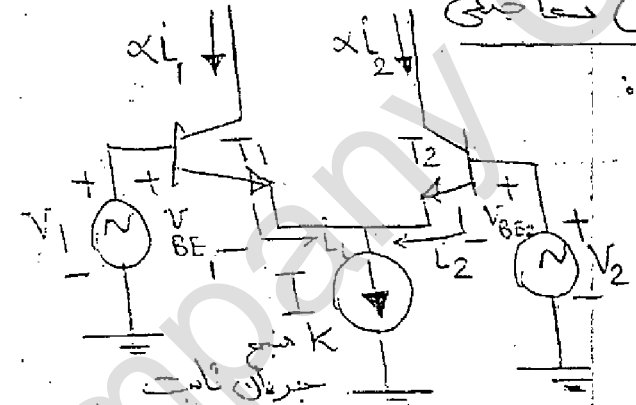
از شکل 9-4:  $-\frac{V_i}{V_p} = 1 \Rightarrow \frac{G_m}{g_{m0}} = 0.2$

$g_{m0} = \frac{2I_{DSS}}{-V_p} = \frac{2 \times 10 \text{ mA}}{5 \text{ V}} = 4 \text{ mS}$

$\Rightarrow G_m = 0.8 \text{ mS} \Rightarrow I_1 = G_m V_i = 0.8 \times 5 = 4 \text{ mA}$   
 دانه ها - موئیک اصلی

$\Rightarrow V_o(t) = V_{DD} - R I_1 \cos(\omega_0 t) = 12 - 8 \cos(10^7 t)$

مشخصه‌های زوج تقاضایی



مدار زیر را در نظر بگیرید:  
 ترانزیستورهای  $T_1$  و  $T_2$   
 مشابه هستند.

$I_1 = I_{S1} \exp\left(\frac{V_{BE1}}{V_T}\right)$  و  $I_2 = I_{S2} \exp\left(\frac{V_{BE2}}{V_T}\right)$

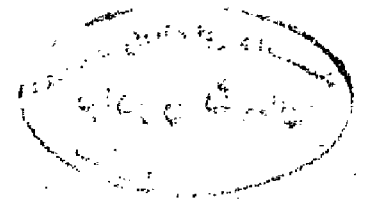
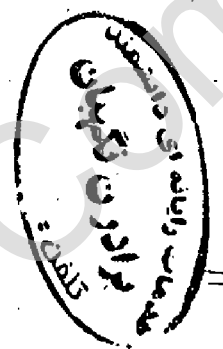
$V_{BE1} - V_{BE2} = V_1 - V_2$  و  $I_1 = I_2 = I_K$

نتیجه می شود:

$\frac{I_1}{I_2} = \exp\left(\frac{V_1 - V_2}{V_T}\right)$

از طرفی داریم:

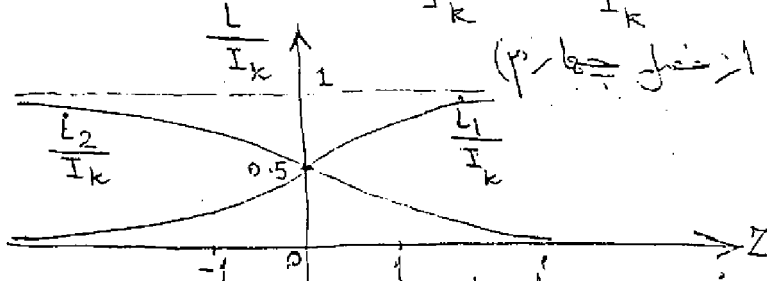
$I_1 + I_2 = I_K$



$$z \triangleq \frac{V_1 - V_2}{\sqrt{T}}$$

$$\Rightarrow I_2 e^{z/2} + I_1 e^{-z/2} = \frac{I_k}{k} \rightarrow \boxed{I_2 = \frac{I_k}{1 + e^z}} \quad \text{و} \quad \boxed{I_1 = \frac{I_k}{1 + e^{-z}}}$$

جریانهای ترانزیستور  $\frac{I_1}{I_k}$  و  $\frac{I_2}{I_k}$  را میتوان بر حسب  $Z$  رسم کرد



( شکل 6-2 از فصل چهارم )

عبارت های  $\frac{I_1}{I_k}$  و  $\frac{I_2}{I_k}$  را میتوان نوشت:

$$\frac{I_1}{I_k} = \frac{1}{1 + e^{-z}} = \frac{e^{z/2}}{e^{z/2} + e^{-z/2}} = \frac{I_k e^{z/2}}{I_k (e^{z/2} + e^{-z/2})} = \frac{I_k}{2 \times 2 \cosh(z/2)}$$

$$\Rightarrow \frac{I_1}{I_k} = \frac{2(\cosh(z/2) + \sinh(z/2))}{2 \times 2 \cosh(z/2)} = \frac{1}{2} \left\{ 1 + \tanh\left(\frac{z}{2}\right) \right\}$$

$$\frac{I_2}{I_k} = \frac{1}{2} \left\{ 1 - \tanh\left(\frac{z}{2}\right) \right\} \quad \text{همینطور:}$$

به ازای معادله کوچک  $Z$  ( $|V_1 - V_2| \ll V_T$ ) داریم:

$$\tanh\left(\frac{z}{2}\right) \approx \frac{z}{2} \Rightarrow \begin{cases} I_1 = \frac{I_k}{2} \left(1 + \frac{z}{2}\right) \\ I_2 = \frac{I_k}{2} \left(1 - \frac{z}{2}\right) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_1 = \frac{I_k}{2} + \frac{q}{2} \sin(V_1 - V_2) \\ I_2 = \frac{I_k}{2} - \frac{q}{2} \sin(V_1 - V_2) \end{cases} \quad \boxed{\frac{q}{2} \sin = \frac{I_k}{2 V_T}}$$

اهدای گینال کوچک  
تاریخ اندر لیتاس سینگل کوچک هم  $\frac{q}{2}$  حسن تعریف می شود؟

$$g_m \triangleq \frac{-\alpha I_{2ac}}{V_1 - V_2} = \frac{+\alpha I_{1ac}}{V_1 - V_2}$$

$$g_m = \frac{\alpha g_{in}}{2} \quad \text{پس:} \quad I_{1ac} = \frac{g_{in}}{2} (V_1 - V_2)$$



17  
ccir

حال فرض می‌کنیم سگنالهای ورودی بزرگ باشند  
در تقریب گیریم:

$$v_1 - v_2 = v_1 \cos \omega t$$

$$x = \frac{v_1}{v_{T1}}$$

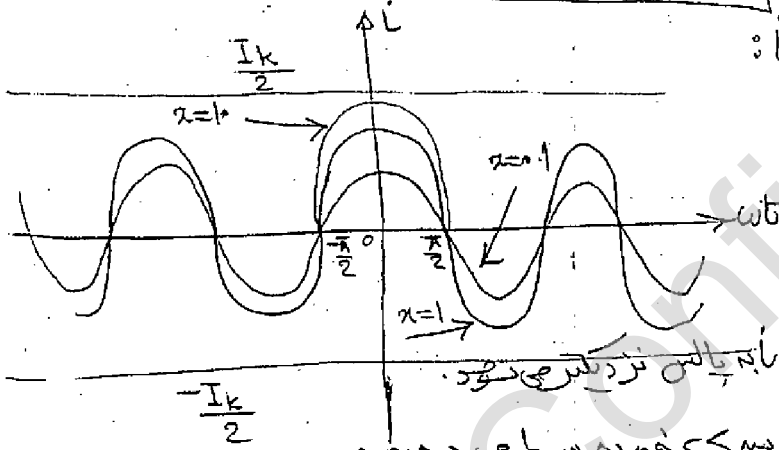
$v_1$  بزرگ است  
دوباره تعریف می‌کنیم:

$$i_1 = \frac{I_k}{2} + i \quad \text{و} \quad i_2 = \frac{I_k}{2} - i$$

داریم:

$$i = \frac{I_k}{2} \tanh\left(\frac{x}{2} \cos \omega t\right)$$

به د- آن:



این هم شکل  $i$ :

با افزایش  $x$  شکل تابع  $i$  نزدیک‌تر می‌شود

سگنال  $i$  را به سری فوریه بسط می‌دهیم:

$$\frac{i}{I_k} = a_0(x) + a_1 \cos(\omega t) + a_2 \cos(2\omega t) + \dots$$

به د- آن:

$$a_n(x) = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{I_k}{2} \tanh\left(\frac{x}{2} \cos \omega t\right) \cos(n\omega t) dt$$

$$\Rightarrow a_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \tanh\left(\frac{x}{2} \cos \theta\right) \cos(n\theta) d\theta = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \tanh\left(\frac{x}{2} \cos \theta\right) \cos n\theta d\theta$$

برای  $n$  زوج داریم:

$$\pi a_n(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \tanh\left(\frac{x}{2} \cos \theta\right) \cos n\theta d\theta + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \tanh\left(\frac{x}{2} \cos \theta\right) \cos n\theta d\theta$$

$\frac{\pi}{2}$

برای  $n$  فرد داریم:

$$\Rightarrow \int_0^{\frac{\pi}{2}} \tanh\left(\frac{x}{2} \cos \theta\right) \cos n\theta d\theta = - \int_0^{\pi} \tanh\left(-\frac{x}{2} \cos \alpha\right) \cos(n\pi - n\alpha) d\alpha$$

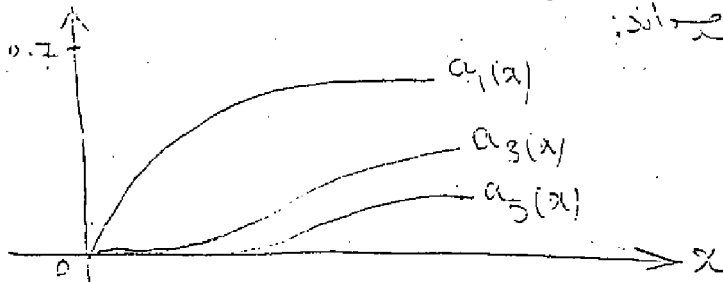
استفاده از  $\alpha = \pi - \theta$

$$= - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \tanh\left(\frac{x}{2} \cos \alpha\right) \cos(n\alpha) d\alpha - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \tanh\left(\frac{x}{2} \cos \alpha\right) \cos(n\alpha) d\alpha$$

$\rightarrow |n| \text{ فرد} \rightarrow n=1, 3, 5, \dots$

تدریس و تالیف دکتر سید علی حسینی

نمودارهای  $a_1(x)$ ،  $a_3(x)$  و  $a_5(x)$  را در شکل 5-6 از فصل 5 کتاب رسم کنید.



اگر روی کلکتور یکی از ترانزیستورها مدار RLC موازی با  $Q_T$  بالا جهت استخراج بار مرفی اصل جریان قرار دهیم خواهیم داشت:

$$V_{ac}(t) = R \times \text{هارمونیك اصلی جريان}$$

هارمونیك اصلی جريان  $= \alpha I_k a_1(x) \cos \omega t$   
 ترانسندوکشن مؤلفه اصلی سیگنال بزرگ را چنین تعریف می‌کنیم:

$$G_m(x) = \frac{\alpha I_k a_1(x)}{V_1} = \frac{\alpha I_k a_1(x)}{\alpha V_T}$$

$$\Rightarrow G_m(x) = \left( \frac{I_k}{2V_T} \right) \frac{2\alpha a_1(x)}{\alpha} = \underbrace{\left( \frac{\alpha g_{in}}{2} \right)}_{g_m} \left( \frac{4a_1(x)}{\alpha} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{G_m(x)}{g_m} = \frac{4a_1(x)}{\alpha}$$

پس  $\frac{G_m(x)}{g_m}$  تابعی از  $x$  خواهد بود.

مورد نمودار این تابع در شکل 5-6 از فصل 5 کتاب رسم کنید.

از فصل 7 کتاب مسائل زیر حل کنید:

- (11) و (12) و (13) و (14) و (18)

خدمات رایانه ای دانشمند  
 برادران نگهبان  
 تلفن ۰۹۱۲۴۵۰۲۰۲

بیان مجدد مدارها را در کتاب انجام دهید

موفقیت برادران دانشمندان عزیز  
 دکتر سید علی حسینی

۰۹۱۲۴۵۰۲۰۲

[ (۱۱) و (۱۲) و (۱۳) و (۱۴) و (۱۸) ]